

## Information



### SU 111

1/84

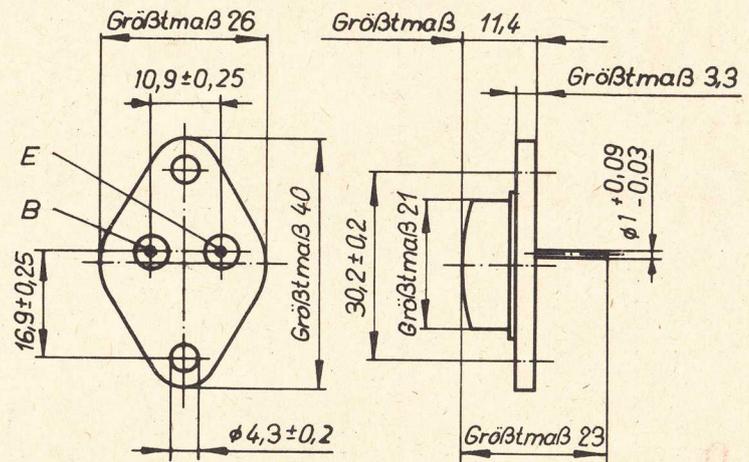
Hersteller: VEB Mikroelektronik "Karl Liebknecht" Stahnsdorf

Si-npn-Darlingtontransistor für elektronische Zündsysteme

Maße in mm und Anschlußbelegung

Masse ca. 22 g

Kollektor am Gehäuse



Grenzwerte, gültig für den Betriebstemperaturbereich

Kollektor-Basis-Spannung  $U_{CBO}$  450 V

$I_E = 0$

Kollektor-Emitter-Spannung  $U_{CEO}$  400 V

$I_B = 0$

Kollektorstrom  $I_C$  10 A

Kollektorspitzenstrom  $I_{CM}$  15 A

Gesamtverlustleistung  $P_{tot}$  120 W

$\vartheta_c \leq 25^\circ\text{C}$

Sperrschichttemperatur  $\vartheta_j$  175 $^\circ\text{C}$

Betriebstemperatur  $\vartheta_a$  125 $^\circ\text{C}$

Kennwerte, bei $\vartheta_c = 25^\circ\text{C}$		min	max
Kollektor-Emitter-Reststrom $U_{BE} = -2\text{ V}, U_{CE} = 450\text{ V}$	$I_{CEX}$		1,0 mA
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung $I_C = 0,1\text{ A}$	$U_{(BR)CEO}$	400 V	
Kollektor-Emitter-Sättigungspannung $I_C = 7\text{ A}, I_B = 0,14\text{ A}$	$U_{CEsat}$		1,8 V
Basis-Emitter-Sättigungsspannung $I_C = 7\text{ A}, I_B = 0,14\text{ A}$	$U_{BEsat}$		2,5 V
Durchlaßspannung der Freilaufdiode $I_{FM} = 7\text{ A}$	$U_{FM}$		3,0

BE-Nr. SU 111: 137 82 82 109 111119

Die vorliegenden Datenblätter dienen ausschließlich der Information! Es können daraus keine Liefermöglichkeiten oder Produktionsverbindlichkeiten abgeleitet werden. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts sind vorbehalten.



**Herausgeber:**  
**vab applikationszentrum elektronik berlin**  
 im vab kombinat mikroelektronik

DDR-1035 Berlin, Mainzer Straße 25  
 Telefon: 5 80 05 21, Telex: 011 2981 011 3055